



2SB1197K (3CG1197K)

硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于一般低频放大。

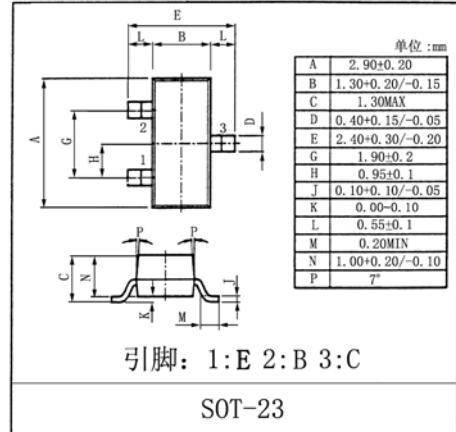
Purpose: Low frequency amplifier applications.

特点:饱和压降低,可与 2SD1781K (3DG1781K)。

Features: Low $V_{CE(sat)}$, complements the 2SD1781K (3DG1781K).

极限参数/Absolute maximum ratings ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CBO}	-40	V
V_{CEO}	-32	V
V_{EBO}	-5.0	V
I_C	-800	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$



电性能参数/Electrical characteristics ($T_a=25^\circ\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition	数值 Rating			单位 Unit
		最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CBO}	$I_C=-50\ \mu\text{A}$	-40			V
V_{CEO}	$I_C=-1.0\text{mA}$	-32			V
V_{EBO}	$I_E=-50\ \mu\text{A}$	-5.0			V
I_{CBO}	$V_{CB}=-20\text{V}$			-0.5	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=-4.0\text{V}$			-0.5	μA
h_{FE}	$V_{CE}=-3.0\text{V}$ $I_C=-100\text{mA}$	120		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$ $I_B=-50\text{mA}$			-0.5	V
f_T	$V_{CE}=-5.0\text{V}$ $I_E=50\text{mA}$ $f=100\text{MHz}$	50	200		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}$ $I_E=0$ $f=1.0\text{MHz}$		12	30	pF

h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	Q	R
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	120~270	180~390
印章 Marking	HAHQ	HAHR

